

【LIVE配信】

【アーカイブ配信】

ALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術の基礎と応用

◆日時：2025年06月16日(月) 10:00～16:00

【アーカイブ配信：6/17～7/1(何度でも受講可能)】

◆会場：【WEB限定セミナー】※ご自宅や職場でご受講下さい。

◆受講料：1名につき55,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき**49,500円**・2名同時にお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で55,000円)**

・ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴いずれも受講料は同じです。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究領域 教授 博士(工学) 浦岡 行治 氏

【講座趣旨・プログラム】※詳細内容は弊社HPでご確認下さい。

AIや5GなどIoT技術の進歩を支えている半導体加工技術において、高機能な薄膜を形成することは、非常に重要である。薄膜形成技術については、古くからいろいろな手法が開発され、LSI、ディスプレイ、太陽電池などのエレクトロニクスの分野で広く活用されてきた。本セミナーでは、近年、特に注目を浴びているALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術について、その基礎と応用について概説する。特に、堆積の原理や材料について詳しく紹介する。また、LSI、薄膜トランジスタ、パワーデバイスに応用した時の特長や課題についても紹介する。

1. 薄膜形成技術

1.1 薄膜作製/加工の基礎

1.2 薄膜の評価手法

1.2.1 電気的評価

1.2.2 化学的分析手法

1.2.3 光学的評価手法

2. ALD/ALE技術の基礎

2.1 ALD技術の原理

2.2 ALD薄膜の特長

2.3 ALD技術の歴史

2.4 ALD装置の仕組み

2.5 ALD技術の材料

2.6 ALE技術の基礎

2.7 ALE技術の課題

3. ALD/ALE技術の応用

3.1 パワーデバイスへの応用

3.2 酸化物薄膜トランジスタへの応用

3.3 MOS LSIへの応用

3.4 太陽電池への応用

4. ALD/ALE技術の将来

4.1 ALD/ALE技術の課題

4.2 ALD/ALE技術の展望

本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

1) Zoomを使用されたことがない方は、こちら(https://zoom.us/download#client_4meeting)からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ブラウザ版でも受講可能です。2) セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。はじめかたについてはこちら(<https://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>)をご覧ください。

3) 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。セミナー開始10分前までにメールに記載されている視聴用URLよりご参加ください。

・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

『ALD』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒< ☐LIVE ☐アーカイブ >

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属	E-Mail	
①			
②			

●Webセミナーの受講申込みについて●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。上記のLIVEかアーカイブにチェックを入れて下さい。弊社から受付完了のご連絡をいたしまして請求書をお送りいたします。

セミナーお申込み後、ご都合により出席できなかった場合は代理の方がご出席下さい。代理の方も見つからない場合、営業日(土日祝日を除く)で8日前まででしたらキャンセルをお受けします。

受講料の支払いに関してはHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール ☐郵送